



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2012132332/08, 27.07.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 27.07.2012

(43) Дата публикации заявки: 10.02.2014 Бюл. № 4

Адрес для переписки:

346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко,
147, ЮРГУЭС, патентная служба

(71) Заявитель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Южно-
Российский государственный университет
экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО
"ЮРГУЭС") (RU)

(72) Автор(ы):

Прокопенко Николай Николаевич (RU),
Сухинин Борис Михайлович (RU),
Кругчинский Сергей Георгиевич (RU),
Будяков Алексей Сергеевич (RU)**(54) УПРАВЛЯЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХПРОЦЕССА SG25VD****(57) Формула изобретения**

Управляемый избирательный усилитель для техпроцесса SG25VD, содержащий источник входного напряжения (1), выходной транзистор (2), база которого подключена к источнику вспомогательного напряжения (3), а коллектор через последовательно соединенные первый (4) и второй (5) частото-задающие резисторы связан с первой (6) шиной источника питания, первый (7) корректирующий конденсатор, второй (8) корректирующий конденсатор, включенный между эмиттером выходного транзистора (2) и общим узлом первого (4) и второго (5) частото-задающих резисторов, цепь установления статического режима (9) выходного транзистора (2), вторую (10) шину источника питания, отличающийся тем, что источник входного напряжения (1) соединен с коллектором выходного транзистора (2) через первый (7) корректирующий конденсатор, в качестве цепи установления статического режима (9) выходного транзистора (2) используется токостабилизирующий двухполосник, включенный между эмиттером выходного транзистора (2) и второй (10) шиной источника питания, выход устройства (11) связан с общим узлом последовательно соединенных первого (4) и второго (5) частото-задающих резисторов, эмиттер выходного транзистора (2) соединен с базой первого (12) дополнительного транзистора, эмиттер которого подключен к эмиттеру второго (13) дополнительного транзистора и соединен со второй (10) шиной источника питания через первый (14) дополнительный токостабилизирующий двухполосник, база второго (13) дополнительного транзистора соединена с эмиттером третьего (15) дополнительного транзистора и через второй (16) токостабилизирующий двухполосник соединена со второй (10) шиной источника питания, причем коллектор второго (13) дополнительного транзистора соединен с коллектором выходного транзистора (2), коллектор первого (12) дополнительного транзистора соединен с

коллектором третьего (15) дополнительного транзистора и связан с первой (6) шиной источника питания, а база третьего (15) дополнительного транзистора соединена с источником вспомогательного напряжения (3).

RU 201213232 A

RU 201213232 A